

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ В НОРМАЛЬНОМ МЕТАЛЛЕ НА СВОЙСТВА SNS-КОНТАКТА

Б.З.Спивак, Д.Е.Хмельницкий

Показано, что квантовые поправки к проводимости нормального металла, находящегося между двумя сверхпроводниками, зависят от разности фаз параметра порядка в сверхпроводниках. Если к SNS-контакту приложено напряжение, то ток через контакт осциллирует с частотой вдвое большей, чем джозефсоновская частота. Предложено граничное условие для "куперона" на границе нормального металла и сверхпроводника.

1. Известно, что в нормальном металле со случайно расположенными примесями когерентность фазы волновой функции электронов сохраняется на расстояниях L , значительно больших длины свободного пробега l . В рамках классической кинетики ($p_F l \gg 1$) это

явление не проявляется. Однако в последнее время было обнаружено, что квантовые поправки к кинетическим коэффициентам целиком определяются этой фазовой памятью^{1,2}. Чувствительность фазы волновой функции к слабым магнитным полям приводит к аномальному магнитосопротивлению^{3,4}, а также к эффекту Ааронова – Бома в неупорядоченных проводниках^{5,6}.

В настоящей работе показано, что фаза волновой функции электрона в нормальном металле, граничащем со сверхпроводником, чувствительна к фазе χ параметра порядка в сверхпроводнике $\Delta = |\Delta| e^{i\chi}$. Это приводит к тому, что проводимость SNS-контакта является осциллирующей функцией разности фаз сверхпроводников $\varphi = \chi_1 - \chi_2$ с периодом π . Поэтому, если к SNS-контакту приложено напряжение V , то ток через контакт, кроме постоянной составляющей, содержит также осциллирующую с частотой $\omega = 4eV/\hbar$, которая в два раза больше джозефсоновской частоты.

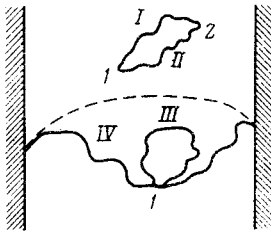


Рис.1.

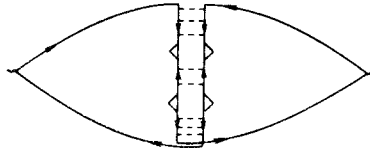


Рис.2.

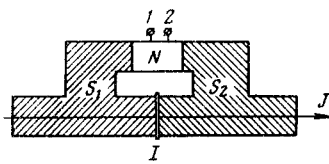


Рис.3.

2. Рассмотрим контакт сверхпроводника и нормального металла при температуре $T \ll |\Delta|$. Электрон, падая из нормального металла на границу со сверхпроводником, может испытывать как обычное, так и андреевское отражение, при котором электрон превращается в дырку с противоположно направленным импульсом. Амплитуда андреевского отражения равна $re^{i\chi}$ ($r \leq 1$).

Механизм возникновения квантовых поправок к проводимости качественно проиллюстрирован на рис.1. Вероятность перехода электрона из точки 1 в точку 2 определяется квадратом суммы амплитуд вероятностей, которые соответствуют различным диффузионным траекториям, связывающим точки 1 и 2 (траектории I, II, III на рис.1). При $p_F l \gg 1$ различным траекториям отвечают сильно различающиеся фазы амплитуд вероятностей. Поэтому интерференцией амплитуд, отвечающим различным траекториям, можно пренебречь. Исключение составляют траектории, для которых с точностью до длины волны электрона $\chi = h/p_F$ точки 1 и 2 совпадают (траектории III и IV на рис.1). Каждая такая траектория может быть пройдена двумя способами, отличающимися различными направлениями обхода замкнутой петли. Учет интерференции амплитуд, соответствующих этим двум траекториям, и приводит к квантовым поправкам к проводимости^{1,2}. Среди возвращающихся траекторий имеются такие, на которых электрон (сплошная линия на рис.1) испытывает андреевское отражение на границе со сверхпроводником и превращается в дырку (пунктирная линия на рис.1). Интерференционные слагаемые, соответствующие таким траекториям, пропорциональны $\cos 2\varphi$ ($\varphi = \chi_1 - \chi_2$). Это происходит потому, что при превращении электрона в дырку волновая функция приобретает дополнительную фазу $\chi_{1,2}$, а при превращении дырки в электрон – фазу $-\chi_{2,1}$. Рассмотренная интерференция экспоненциально затухает, когда толщина нормального металла превышает диффузионную длину с боя фазы $L_\varphi = \sqrt{D\tau_\varphi}$, где $D = \frac{1}{3}v_F l$ – коэффициент диффузии электронов, τ_φ – время с боя фазы. При низких температурах $L_\varphi \gg \xi_T = \sqrt{D\hbar/T}$ (ξ_T – длина когерентности нормального металла, на которой исчезают эффекты близости).

3. Квантовая поправка к проводимости определяется верной диаграммой², которая изображена на рис.2 с учетом возможности андреевского отражения. Важным элементом этой диаграммы является куперон $C(\mathbf{r}, \mathbf{r}', t_1, t_2, t_3, t_4) = \langle \psi(\mathbf{r}, t_1) \psi(\mathbf{r}, t_2) \psi^+(\mathbf{r}', t_3) \psi^+(\mathbf{r}', t_4) \rangle$. Квантовая поправка к проводимости выражается через куперон с помощью формулы

$$\Delta\sigma = -\frac{2\sigma_0}{\pi\nu} \int_{-\infty}^{\infty} d\eta C_{-\eta\eta}^t(\mathbf{r}, \mathbf{r}). \quad (1)$$

Здесь ν – плотность состояний на поверхности Ферми, σ_0 – проводимость металла, определяемая формулой Друде. Куперон $C_{\eta,\eta}^t(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \delta_{t,t'}$ подчиняется уравнению^{2,3,7,8}

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial\eta} + D \left[-i \vec{\nabla} - \frac{e}{c\hbar} \mathbf{A} \left(\mathbf{r}, t + \frac{\eta}{2} \right) - \frac{e}{c\hbar} \mathbf{A} \left(\mathbf{r}, t - \frac{\eta}{2} \right) \right]^2 + \frac{1}{\tau_\varphi} \right\} C_{\eta,\eta}^t(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \\ = \frac{1}{\tau} \delta(\eta - \eta') \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (2)$$

Здесь $\tau = l/v_F$ – время свободного пробега, $\eta = t_1 - t_2$, $t = \frac{1}{2}(t_1 + t_2)$, $\eta' = t_3 - t_4$, $t' = \frac{1}{2}(t_3 + t_4)$, $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ – вектор-потенциал электромагнитного поля.

В нормальном металле, граничащем со сверхпроводником, как известно, необходимо пользоваться двухкомпонентной волновой функцией C^\pm , включающей волновые функции электрона и дырки. Поэтому уравнение (2) для C^+ должно быть дополнено комплексно-сопряженным уравнением для функции C^- . На границе со сверхпроводником эти уравнения должны быть дополнены граничными условиями

$$\mathbf{n} \vec{\partial} C_{\eta,\eta}^+ = \mathbf{n} \vec{\partial} C_{\eta,\eta}^- \exp \left\{ i \chi \left(t + \frac{\eta}{2} \right) + i \chi \left(t - \frac{\eta}{2} \right) \right\}, \quad (3)$$

$$C_{\eta,\eta}^+ - C_{\eta,\eta}^- \exp \left\{ i \left[\chi \left(t + \frac{\eta}{2} \right) + \chi \left(t - \frac{\eta}{2} \right) \right] \right\} = \begin{cases} 0, & \text{при } r \lesssim 1 \\ \frac{D}{\pi\nu_F r^2} \mathbf{n} \vec{\partial} C_{\eta,\eta}^+, & \text{при } r \ll 1, \end{cases} \quad (4)$$

где $\vec{\partial} = \vec{\nabla} - i \frac{e}{c\hbar} \left[\mathbf{A} \left(\mathbf{r}, t + \frac{\eta}{2} \right) + \mathbf{A} \left(\mathbf{r}, t - \frac{\eta}{2} \right) \right]$, \mathbf{n} – нормаль к границе. Условия

(3), (4) написаны по аналогии с граничными условиями для уравнений диффузии для двухкомпонентной смеси, в которой имеется конечная вероятность взаимного превращения на границе. Если опустить множитель $\exp \{ i [\chi(t_1) + \chi(t_2)] \}$, то уравнение (3) описывает сохранение полного числа частиц, а уравнение (4) связывает разность концентраций компонент на границе с потоком одной из компонент. Как обычно, разность концентраций возникает только в случае $r \ll 1$; в противном случае концентрации на границе равны. Фазовый множитель $\exp \{ i [\chi(t_1) + \chi(t_2)] \}$ связан с изменением фазы волновой функции квазичастицы при андреевском отражении.

Уравнение (2) и граничные условия (3), (4) позволяют решать задачи о влиянии контакта со сверхпроводником на квантовые поправки к кинетическим коэффициентам в нормальном металле. Квантовая поправка к сопротивлению нормальной прослойки толщиной L в SNS-контакте равна

$$\Delta R = \frac{2e^2}{\pi^2\hbar} R^2 \frac{1}{L} \sum_{Q_{\parallel}} \int \frac{dQ_{\perp}}{(2\pi)^2} \left(Q_{\parallel}^2 + Q_{\perp}^2 + \frac{1}{L^2} \right)^{-1}. \quad (5)$$

Здесь Q_{\parallel} – волновой вектор, являющийся собственным значением граничной задачи для уравнения диффузии с граничными условиями (3), (4). Если $Q_{\perp} l \sim l/L \ll r^2$, то правую часть уравнения (4) можно считать равной нулю. При этом $Q_{\parallel} = (1/L)(\pi n - \varphi)$, где n – целое число.

Формула (5) совпадает с выражением для квантовой поправки к проводимости полого цилиндра в зависимости от магнитного потока, пронизывающего этот цилиндр⁵ (эффект Ааронова – Бома в неупорядоченной системе), если заменить в (5) φ на отношение магнитного потока к кванту магнитного потока, а L – на половину длины окружности цилиндра. Особенно просто формула (5) выглядит, когда поперечные размеры контакта меньше L_φ :

$$\Delta R = \frac{e^2}{\pi \hbar} R^2 \frac{L_\varphi}{L} \frac{\text{sh } L/L_\varphi}{\text{ch } \frac{L}{L_\varphi} - \cos 2\varphi} \quad (6)$$

Остальные предельные случаи рассмотрены в⁵.

4. Рассмотренные выше эффекты можно наблюдать в двух режимах: а) в режиме, когда с помощью джозефсоновского перехода, подсоединенного параллельно к SNS-контакту, зафиксирована фаза (рис.3), и б) в нестационарном режиме. Наиболее просто последний режим реализуется, когда к SNS-контакту приложено напряжение V . В этом случае разность фаз φ удовлетворяет уравнению Джозефсона

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{2eV}{\hbar} \quad (7)$$

Ток через SNS-контакт I связан с V законом Ома $I = \sigma(\varphi)V$ и осциллирует с частотой $\Omega = 4eV/\hbar$, которая вдвое больше частоты Джозефсона:

$$I = \left(\sigma_0 + \sigma_1 \sin \frac{4e}{\hbar} V t \right) V. \quad (8)$$

Выражение (8) справедливо в адиабатическом приближении $\omega = 4eV/\hbar \ll DL^2$, когда за период колебаний электроны успевают продиффундировать вдоль траектории, соединяющей два сверхпроводника (траектория IV на рис.1). При больших ω амплитуда осциллирующей экспоненциально убывает.

5. Рассмотренное явление иммитирует нестационарный эффект Джозефсона в SNS-контакте. Отличие состоит в том, что частота осцилляций вдвое превышает джозефсоновскую частоту $2eV/\hbar$. Подчеркнем что стационарный эффект Джозефсона в рассмотренной нами системе отсутствует.

Для наблюдения рассмотренных выше эффектов необходимо выполнение условия $L_\varphi \gg \xi_T \gg L \gg \xi_T = \sqrt{D\hbar/T}$. Время сбоя фазы τ_φ может быть связано как с неупругими процессами (электрон-фононными и электрон-электронными)^{1,8}, так и с упругими рассеянием на парамагнитных примесях⁹.

Авторы благодарны Б.Л.Альтшулеру, Л.Г.Асламазову, А.И.Ларкину, Ю.Н.Овчинникову, А.Шеланкову, В.В.Шмидту за полезные обсуждения.

Литература

1. Anderson P.W., Abrahams E., Ramakrishnan T.V. Phys. Rev. Lett., 1981, 43, 718.
2. Горьков Л.П., Ларкин А.И., Хмельницкий Д.Е. Письма в ЖЭТФ, 1979, 30, 248.
3. Altshuler B.L., Khmel'nitskii D., Larkin A.I., Lee P.A. Phys. Rev., 1980, B22, 5142.
4. Альтшулер Б.Л., Аронов А.Г., Ларкин А.И., Хмельницкий Д.Е. ЖЭТФ, 1981, 81, 768.
5. Альтшулер Б.Л., Аронов А.Г., Спивак Б.З. Письма в ЖЭТФ, 1981, 34, 285.
6. Шарвин Д.Ю., Шарвин Ю.В. Письма в ЖЭТФ, 1981, 34, 285.
7. Altshuler B.L., Aronov A.G., Khmel'nitskii D.E. Sol. St. Comm., 1981, 39, 619.
8. Altshuler B.L., Aronov A.G., Khmel'nitskii D.E. J. Phys. C., 1982 (to be published).
9. Lee P.A. J. Noncrystal. Sol., 1980, 35, 21.

Институт теоретической физики
им. Л.Д.Ландау
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
15 марта 1982 г.